METHOD OF REDUCING METAL CONTENT IN FLUOROELASTOMER

Publication number: WO9950319

Publication date:

1999-10-07

Inventor:

TANAKA YOSHIYUKI (JP); KITAICHI MASANORI (JP); SOTA TOMIZO (JP); MORIKAWA TATSUYA (JP);

SOGABE TOSHIO (JP); KISHINE MITSURU (JP)

Applicant:,

DAIKIN IND LTD (JP); TANAKA YOSHIYUKI (JP); KITAICHI MASANORI (JP); SOTA TOMIZO (JP);

MORIKAWA TATSUYA (JP); SOGABE TOSHIO (JP);

KISHINE MITSURU (JP)

Classification:

- international:

C08F2/00; C08F6/16; C08F6/22; C08F2/00; C08F6/00;

(IPC1-7): C08F14/18; C08F2/00; C08F6/00

- european:

C08F6/16; C08F6/22

Application number: WO1999JP01517 19990324

Priority number(s): JP19980077235 19980325; JP19990005877 19990112

Also published as:

EP1097948 (A1) WO9950319 (A1) US6703461 (B1)

Cited documents:

JP9500163 WO9708239

JP62285906

] JP9183812] JP51031789

more >>

Report a data error here

Abstract of WO9950319

A method of producing a fluoroelastomer reduced in the content of metallic ingredients; and a molded article comprising a fluoroelastomer sufficiently reduced in the content of metallic ingredients. The method comprises producing a fluoroelastomer without using a metal oxide through fluoromonomer polymerization, coagulation, and drying, wherein at least one of the starting materials excluding gaseous monomers contains substantially no metallic ingredients. The fluoroelastomer obtained by this method has a metal content of 50 ppm or lower.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PCT

世界知的所有権機関 国際 事務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 C08F 14/18, 2/00, 6/00
A1
(11) 国際公開番号
WO99/50319
(43) 国際公開日
1999年10月7日(07.10.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/01517

(74) 代理人

(22) 国際出願日

1999年3月24日(24.03.99)

弁理士 朝日奈宗太, 外(ASAHINA, Sohta et al.) 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町二丁目2番22号

NSピル Osaka, (JP)

(30) 優先権データ

特願平10/77235 特願平11/5877 1998年3月25日(25.03.98) 1999年1月12日(12.01.99) (81) 指定国 CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

ダイキン工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP]

〒530-8323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号

梅田センタービル Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

田中良幸(TANAKA, Yoshiyuki)[JP/JP]

北市雅紀(KITAICHI, Masanori)[JP/JP]

曽田富三(SOTA, Tomizo)[JP/JP]

森川達也(MORIKAWA, Tatsuya)[JP/JP]

曾我部利雄(SOGABE, Toshio)[JP/JP]

岸根 充(KISHINE, Mitsuru)[JP/JP]

〒566-8585 大阪府摂津市西一津屋1番1号

ダイキン工業株式会社 淀川製作所内 Osaka, (JP)

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: METHOD OF REDUCING METAL CONTENT IN FLUOROELASTOMER

(54)発明の名称 含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法

(57) Abstract

A method of producing a fluoroelastomer reduced in the content of metallic ingredients; and a molded article comprising a fluoroelastomer sufficiently reduced in the content of metallic ingredients. The method comprises producing a fluoroelastomer without using a metal oxide through fluoromonomer polymerization, coagulation, and drying, wherein at least one of the starting materials excluding gaseous monomers contains substantially no metallic ingredients. The fluoroelastomer obtained by this method has a metal content of 50 ppm or lower.

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

アラブ首長国連邦 アルバニア アルメニア オーストリア オーストラリア オーストラリジャ ボズニア・ヘ バルバドス ドミニカ エストニア スペインラン フランス ガザ KLLLLLLLLL MMMM ABBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCD GGGGGGGGGHU SSSTTTTTTTTUUUS ベルギー ブルギナ・ファソ ブルガリア トルコトリニダッド・トバゴウガンダ ML MN MR ウガンタ 米国 ウズベキスタン ヴィーゴースラビア 南アフリカ共和国 ジンパブエ MX NELOZLT イタリア 日本 ケニア ッー/ キルギスタン 北朝鮮 韓国 KR

1

明細書

含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法

技術分野

本発明は、金属含有量を低減させた含フッ素エラストマーをうる方法に関し、さらに、かかる方法によってえられる含フッ素エラストマーとその含フッ素エラストマーを含む組成物、および当該組成物からなる成形品に関する。

背景技術

従来から、含フッ素樹脂(プラスチック)に関しては、クリーン度の厳しい要求のある半導体製造プロセスにおいて、薬液の配管、角槽、シリコンウェハのバスケットなど、半導体製品に直接的に影響を与える重要な部位に、しかも大量に用いられてきたため、含フッ素樹脂の金属成分含有量、TOC(全有機炭素)およびパーティクルの含有量を低減させることが積極的に行なわれている。

また、主としてピニリデンフルオライド(VdF)単位なようフルオロエチレン(TFE)単位なゴーロエチレン(TFE)単位なゴートマーに関しては、フッカンに関してはが適用されるがある。まで、加硫甲と取り扱いが配合される。まで、加硫促進剤、受酸剤などが配合にある。なり、薬液の配管や角槽、バスケットなどと異なり、

極くわずかな接触部位に用いられてきたため、特に含フッ素エラストマーそのものの純度や不純物の存在が問題となることはほとんどなかった。

一方、含フッ素エラストマーは、優れた耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性を有するという点から、近年、半導体製造の分野において過酷な環境下において用いられる半導体製造装置用シール材として注目されている。

しかし、半導体製造の分野では高集積化および参数にある半導体チップのコストダウンが急激にあるい半導体製造装置に用いてもない半導体製造装置中になるシール材に対しても、金属成分、TOCおよび一方の出しないこと、また半導体製造装置中になるイクルを含まないになり、シール材を各種溶剤で洗浄するとなっ方法だけでは不充分となってきた。

ても対策が必要となってきた。

さらに、特表平9-500163号公報記載のだがしていた。 おれば、カマークを含さはで製造した。 なっカングかがあることでもの方法でもの方法でものかなができたいのではできたいのではできたいのではでいる。 は、カーリングをおいるのではいる。 は、カーリングをあるといるがのかなができたいのでである。 は、マーリンでものかなができたいのではできたかができたいでである。 は、マーリンでものはできたいのではできたかができた。 されているのはできたいのとのはできたかができたができたができた。 というな低減は達成されない。

一方、特表平 8 - 5 0 6 6 0 4 号公報記載の技術によれば、加硫を金属化合物を用いず電子線を照射することにより行なっているが、この加硫物には依然として凝析剤に起因すると思われる金属成分が 1 0 0 p p m のオーダーで含まれている。

すなわち、従来の含フッ素エラストマーは、製造の際に重合開始剤、凝析剤などとして金属化合物を用いるるに、金属成分を本質的に含有しうる。また、製造ののでは、金属成分を本質的になる。のでは、一手ィクルが存在することになる。

また、従来の金属成分含有量の評価は特定の溶出(抽出)条件下での溶出量で行なっているため、処理条件が異なれば、溶出量も大きく異なってくるのが現状である。

したがって、あらゆる環境や処理に対応できる、本質的に内部から金属成分が低減された含フッ素エラストマー、ならびに金属成分含有量が充分に低減された含フッ

4

素エラストマーからなるシール材はえられていないのが現状である。

叙上の事実に鑑み、本発明の目的は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの金属成分含有量を内部から本質的に低減化する方法を提供し、さらに、結果として金属成分含有量が充分に低減された含フッ素エラストマーからなる成形品、特にシール材を提供することにある。

発明の開示

本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素モノマーを乳化重合させる際に金属化合物を配合しない含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、金属化合物を用いない含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いるガス状のモノマーを除く原材料のうち少なくとも1つの原材料を、実質的に金属成分を含まない原材料とする含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

このばあい、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が重合媒体用の水であるのが好ましい。

また、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が凝析用の凝析剤であるのが好ましい。

また、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が凝析してえられる含水含フッ素エラストマーから水分を分離する際に添加する該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤であるのが好ましい。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、乳化液を弱アルカリ性に保持して含フッ素エラストマーの乳化重合を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を濾過して汚染物質を除去したのちに凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、金属元素を含まない酸を用いて含フッ素エラストマーの乳化分散液の凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマー、または該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離してえられるエラストマー凝析物を、清浄なガスを用いて乾燥させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、エラストマー凝析物と接触する部分がフッ素樹脂製フィルムまたはポリエチレン製フィルムをラミネートし

た容器、フッ素樹脂製容器およびポリエチレン樹脂製容器を用いる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は前記方法のうち少なくとも2つの方法からなる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、金属化合物を用いない含フッ素子、経い合フッ素子の重合を用いなっての製造においるすべての原材料に実質的的液がで、乳化を含まるが、乳化を用い、乳化が変形があるが、乳化で作製されてを設めまたはポーンを関があるが、からはかいで作製されて、発酵がある。

本発明は、金属含有量が 5 0 p p m 以下、好ましくは 1 0 p p m 以下、より好ましくは 1 p p m 以下の含フッ素エラストマーに関する。

また、本発明は前記方法の1つまたは2つ以上を組合せてえられる金属含有量が50pm以下、好ましくは10pm以下の含フッ素エラストマーにも関する。

このばあい、含フッ素エラストマーが、テトラフルオロエチレン40~90モル%、式(1):

C F = C F - O R

(式中、R、は炭素数 1 ~ 5 のパーフルオロアルキル基、または炭素数 3 ~ 1 2 でかつ酸素原子を 1 ~ 3 個含むパーフルオロアルキル (ポリ) エーテル基) で表されるパーフルオロビニルエーテル 1 0 ~ 6 0 モル%、および硬

化部位を与える単量体0~5モル%からなるのが好ましい。

また、前記含フッ素エラストマーが、ビニリデンフルオライド30~85モル%、ヘキサフルオロプロピレン15~40モル%およびテトラフルオロエチレン0~30モル%からなるのが好ましい。

また、前記含フッ素エラストマーが、ビニリデンフルオライド $10 \sim 90$ モル%、式(1): $CF_2 = CF$ - ORf(式中、Rf は前記と同様。) で表されるパーフルオロビニルエーテル $10 \sim 40$ モル% およびテトラフルオロエチレン $0 \sim 80$ モル%からなるのが好ましい。

また、前記含フッ素エラストマーが、ビニリデンフルオライド40~90モル%、パーフルオロ(メチルリコルエーテル)(PMVE)3~35モル%、ヘキサフルオロプロピレン0~25モル%、テトラフルオロエチレン0~40モル%、および硬化部位を与える単量体として含ヨウ素モノマー(IM)0.005~1.5モル%からなるのが好ましい(WO96/17877パンリット参照)。ここで、含ヨウ素モノマーとしては、式(4):I(CH2CF2CF2O)m[CF(CF3)CF2O]nCF=CF2(式中、mは1~5の整数である。)で表わされるヨウ素含有フッ素化ビニルエーテルを好ましく用いることができる・

また、前記含フッ素エラストマーが、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントと非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントを有する含フッ素多元セグメント化ポリマーであって、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが、テトラフルオロエチレン40~9

0 モル%、式(1):

 $CF_{2} = CF - OR_{1}$

(式中、R、は前記と同様。)で表わされるパーフルオロビニルエーテル10~60モル%、および硬化部位を与える単量体0~5モル%からなり、非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが、テトラフルオロエチレン85~100モル%、式(2):

 $C F_{2} = C F - R_{f}^{1}$

(式中、 R_1 は CF_3 または OR_2 (R_2 は炭素数 $1\sim 5$ のパーフルオロアルキル基)) $0\sim 1$ 5 モル%からなるのが好ましい。

また、前記した各含フッ素エラストマーが、末端および/または側鎖にヨウ素および/または臭素を有するポリマー鎖を含むのが好ましい。

また、前記含フッ素エラストマーが、ニトリル基を含むのが好ましい。

また、本発明は、前記含フッ素エラストマーを含む組成物にも関する。

さらに、本発明は、前記組成物からなる成形品にも関する。

本発明は金属含有量が50pm以下、好ましくは10pm以下の成形品にも関する。

前記成形品は、半導体製造装置用シール材であるのが好ましい。

本発明はまた、含フッ素ポリマーの製造において、重合用原材料および生成物と接触する部分がフッ素樹脂でライニングされた装置を用いる含フッ素ポリマーの金属含有量低減化方法に関する。

このばあい、フッ素樹脂でライニングされた装置が、重合槽およびそれに付属する撹拌翼、邪魔板などの重合装置、凝析装置、洗浄装置、乾燥装置、およびこれらの配管類であるのが好ましい。

また、フッ素樹脂がテトラフルオロエチレン/パーフルオロ (アルキルピニルエーテル) 共重合体 (PFA) であるのが好ましい。

図面の簡単な説明

図 1 は、本発明による含フッ素エラストマーの製造方法の工程を説明するためのフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

まず、本発明の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法の基礎となる含フッ素エラストマーの製造方法の各工程を説明するためのフローチャートを図1に示す。 以下に、図1に示す含フッ素エラストマーの製造工程の順序にしたがって、本発明の方法を説明する。

まず、本発明にもとづく含フッ素エラストマーの製造においては、含フッ素モノマーを乳化重合させる際に金属化合物を配合しない。

すなわち、本発明は、含フッ素モノマーを乳化重合させる際に金属化合物を配合しない含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

従来の含フッ素エラストマーの製造方法においては、 原材料として、過硫酸カリウム、亜硫酸ナトリウム、硫酸第一鉄などの重合開始剤など、金属原子を含むものが 通常用いられていたため、えられる含フッ素エラストマ 一中に金属成分が含まれていた。そこで、本発明においては、特に前記課題を解決するため、全ての原材料に金属原子を含まない化合物を用い、さらに、少なくとも1つの原材料として、「実質的に金属成分を含まない原材料」を用いることを特徴とする。

本発明において、「実質的に金属成分を含まない」とは、金属化合物を用いないことは当然であるが、不純物としても金属化合物を徹底的に排除したものをいう。具体的には、原材料の金属成分含有量が20ppb以下、好ましくは10ppb以下であることをいう。

ここで、本発明においていう金属成分とは、後述する 方法により測定されるNa、K、Fe、Ni、Al、C u、Cr、Zn、CaおよびMgをいう。

本発明においていう原材料とは、含フッ素モノマー、水、乳化剤、ヨウ素化合物などの連鎖移動剤、重合開始剤、アンモニアなどのpH調整剤、凝析剤などをいう。なかでも、含フッ素モノマー、乳化剤、ヨウ素化合物、重合開始剤、凝析剤については、金属をその構成する原子に含まないものを用いるのが重要である。

 テルであるのが好ましい。

また、本発明の効果およびエラストマーの性質を損なわない範囲であれば、その他のモノマーを含んで化性を付与するプロピレン(Pr)、圧縮永久歪性を付与する式(4):I(CH2CF2CF2O)m [CF (CF3)CF2O]n CF=CF2(式中、mは1~5の整数であるり、nは0~3の整数である。)で表わされるヨウまり、nは0~3の整数である。)で表わされるヨウまる
り、nは0~3の整数である。)が表わされるコーカーの表化ビニルエーテル、また、特開平7~3162

 $C X_2 = C X - R_1^2 - C H R - I$

$$CF_2 = CF (OCF_2 CF_{\frac{1}{2}m} O + CF_2)_{\frac{1}{n}} CN$$

(式中、mは0~5、nは1~3)

$$CF_3 - CF - (CF_2 OCF)_{\overline{n}} CF_2 OCF = CF_2$$

$$CN \qquad CF_3$$

(n は 1~4)、

12

$$CF_2 = CFO (CF_2) \cap OCF (CF_3) CN$$

(n は 2~5)、

$$CF_2 = CFO - (CF_2) - CN$$

(n は 1~6)、

 $CF_2 = CF [OCF_2 CF (CF_3)]_n OCF_2 CF (CF_3) CN$

(nは1~2)、または

$$CH_2 = CFCF_2 O - (CFCF_2 O) - CF - CN$$

$$CF_3 CF_3$$

具体的に好ましいモノマーの組み合わせとしては、T FE/PAVE、VdF/HFP、VdF/TFE/H FP, VdF/PAVE/TFE, VdF/PMVE, VdF/HFP/PMVE,VdF/TFE/PMVE, V d F / P M V E / H F P / T F E およびT F E / P r / その他の単量体があげられる。TFE/PAVEのば あいの組成としては、40~90/10~60(モル%) であるのが好ましく、VdF/TFE/HFPのばあい の組成としては、30~85/0~30/15~40(モ ル%) であるのが好ましく、VdF/PAVE/TFE のばあいの組成としては、10~90/10~40/0 \sim 8 0 (モル%) であるのが好ましい。また、V d F /PMVEのばあいの組成としては、65~90/10~ 35 (モル%)、VdF/HFP/PMVEのばあいの 組成としては、6 5 ~ 9 0 / 3 ~ 2 5 / 3 ~ 2 5 (モル%)、 V d F / T F E / P M V E のばあいの組成としては、 4

組成としては、6 5 ~ 9 0 / 3 ~ 2 5 / 3 ~ 2 5 (モル%)、V d F / T F E / P M V E のばあいの組成としては、 4 0 ~ 8 0 / 3 ~ 4 0 / 1 5 ~ 3 5 (モル%)、 V d F / P M V E / H F P / T F E のばあいの組成としては、 4 0 ~ 8 0 / 3 ~ 2 5 / 3 ~ 4 0 (モル%) であるのが好ましい。また、 T F E / P r / その他の単量体のばあいの組成としては、 4 0 ~ 7 0 / 3 0 ~ 6 0 / 0 ~ 2 0 (モル%) であるのが好ましい。

また、本発明に用いる含フッ素エラストマーとしては、シール性やクリーン性が要求される各種成形品の成形に好適に用いる成形用材料として特願平9-304684号明細書に記載されている含力が表別に好きしてもよい、具体的に好ましてであっては、エラストできるとして、ストピーの鎖セグメントとして、ストピーとがあげられ、ストピーのである。モルルのであるは、エラストであり、は、エラストでは、エラストのでは、エラストのでは、エラストのでは、エラストのでは、エラストでは、エラストでは、エラストでは、ロー性含フッ素ポリマー鎖セグ、たらの/0~5、特に53~70/30~45/0~2であり、非エラストでは、ストとして、具体的には、

(1) VdF/TFE (0~100/100~0)、特にVdF/TFE (70~99/30~1)、PTFE またはPVdF;

(2) エチレン/TFE/HEP(6~60/40~8 1/1~30)、3,3,-トリフルオロプロピレン -1,2-トリフルオロメチル-3,3,3-トリフル オロプロピレン-1/PAVE(40~60/60~4 0);

- (3) TFE/CF₂ = CF-R₁¹(非エラストマー性を示す組成範囲、すなわち、CF₂ = CF-R₁¹が15 モル%以下);
- (4) VdF/TFE/CTFE (50~99/30~0/20~1);
- (5) V d F / T F E / H F P (60 ~ 99 / 30 ~ 0 / 10 ~ 1);
- (6) IFVV/TFE(30~60/70~40);
- (7)ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE);
- (8) エチレン/CTFE(30~60/70~40) などがあげられる。

本発明において用いる水は、金属含有量が前記範囲にあるものであればよいが、なかでも、金属およびTOC含有量が非常に少ない超純水を用いるのが好ましい。

本発明において用いる「実質的に金属成分を含まない」水は、たとえば逆浸透膜(RO)、限外濾過(UF)、マイクロフィルター(MF)などの膜分離法やイオン交換樹脂、活性炭吸着、UV酸化などの従来公知の方法を、多段利用も含めた連続プロセスとして用いることにより製造することができる。

超純水製造方法の一例としてはつぎのプロセスがあげられる。

- ①前処理システム(工業用水、地下水→前処理水): これは除濁および一次滅菌のために行なう。手段としては、凝析沈殿、凝集濾過、活性炭吸着、マイクロフィルター(MF)を用いる。
 - ② 一 次 純 水 シ ス テ ム (前 処 理 水 → 一 次 純 水) : こ れ は

脱塩のために行なう。手段としては、大半の溶解塩、有機物、微粒子および生菌の除去のために逆浸透(RO)を用い、精密脱塩のためにイオン交換樹脂を用いる。

③サブシステム(一次純水→超純水): これは一次純水中のイオンおよび微粒子の除去ならびに殺菌のために行なう。手段としては、有機物を分解するためにUV酸化を用い、コロイド状物質および高分子物質除去のために限外濾過(UF)を用い、精密脱塩のためにイオン交換樹脂を用いる。

本発明において用いる乳化剤としては金属原子を含まないものであれば特に制限はなく、たとえば、重合中におこる乳化剤分子への連鎖移動反応を抑制する観点から、フルオロカーボン鎖またはフルオロポリエーテル鎖を有するカルボン酸の塩類が好ましい。

具体的には、たとえば、パーフルオロオクタン酸アンモニウム、CF $_3$ (CF $_2$) $_n$ COONH $_4$ (n = 7 ~ 8)、CHF $_2$ (CF $_2$) $_n$ COONH $_4$ (n = 6 ~ 8)、C $_3$ F $_7$ OCF (CF $_3$) CF $_2$ OCF (CF $_3$) COONH $_4$ などがあげられる。

乳化剤の使用量は、添加された水の約 0 . 0 5 ~ 1 0 重量%であるのが好ましく、特に 0 . 2 ~ 5 . 0 重量% であるのが好ましい。

本発明において連鎖移動剤として用いるヨウ素化合物としては、金属原子を含まず、たとえば、1,3-ジョードパーフルオロプロパン、1,4-ジョードパーフルオロブタン、1,3-ジョード-2,4-ジクロロパーフルオロプロパン、1、5-ジョード-2,4-ジクロロパーフルオロペンタン、1,6-ジョードパーフルオロヘキ

つぎに本発明においては、含フッ素モノマーの重合を 行ない、乳化分散液を製造する。

用いる重合開始剤としては、金属原子を含まないものであれば特に制限はなく、たとえば、有機および無機の

過酸化物ならびにアソ化合物があげられる。典型的なものとしては、過硫酸塩、過酸化カーボネート、過酸化エステルなどがあり、なかでも過硫酸アンモニウム(APS)を用いるのが好ましい。また、APSは単独で用いてもよいが、サルファイト、亜硫酸塩などの還元剤(金属原子を含まない)と組み合わせて用いてもよい。

また、このとき、乳化液を弱アルカリ性に保持して含フッ素モノマーの乳化重合を行なうことにより金属成分の混入を防ぐことができる。

したがって本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、乳化液を弱アルカリ性に保持して含フッ素モノマーの乳化重合を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法にも関する。

特に含フッ素モノマーを乳化重合させて含フッ素エラストマーを製造するばあい、重合中にフッ素イオンが発生し、重合装置の金属成分の溶出を促進させ、ポリマーに混入し、汚染するという可能性がある。

そこで、本発明においては、重合中に発生したフッ素 イオンを中和するために、乳化液を弱アルカリ性に保持 して含フッ素モノマーを乳化重合する。

乳化液を弱アルカリ性に保持する方法としては、金属化合物を用いないという点から、アンモニア水、炭酸アンモニウムなどのアンモニア化合物をpH調整剤として添加する方法があげられる。

ここで、「弱アルカリ性」とは、 p H 7 ~ 1 0 程 度 であることをいう。

なお、 p H 調整剤は、乳化液を製造する際に含フッ素 モノマーなどの成分と同時に混合すればよい。 本発明においてモノマーを組み合わせて用いるばあい、特にテトラフルオロエチレンとパーフルオロ(メチルビニルエーテル)の混合ガスを用いるばあい、カルプ(G・H・Kalb)ら、アドバンシーズ・イン・ケミストリー・シリーズ(Advances in Chemistry Series)129,13(1973)に記載されるように、爆発性を有するので、重合装置には着火源となるスパークなどが発生しないように工夫する必要がある。また、この点から、重合圧力はできる限り低く抑えるのが好ましい。

重合温度としては、通常乳化重合にて採用される温度であればよいが、ポリマーラジカルの安定性という点から、5~100℃であるのが好ましい。

また、重合圧力は、広い範囲で変化させることができる。一般には、7MPaより低い。重合圧力が高いほど 重合速度が大きくなるため、生産性の向上の観点から、 0.1MPa以上であるのが好ましい。

つぎに、本発明においては、前述のように乳化重合してえられる乳化分散液を凝析工程に供し、含水含フッ素エラストマーを製造する。

ここで本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、 凝析剤として金属元素を含まない酸を用いて含フッ素エラストマーの乳化分散液の凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法にも関する。

本発明において用いる凝析剤としては、金属原子を含まない従来のものであれば特に制限はなく、たとえば、塩酸、硝酸、フッ酸、硫酸、トリフルオロ酢酸などの一般的な酸類があげられるが、汎用性や高純度化が可能なこと、使用量という点から、塩酸、硝酸、硫酸を用いるのが好ましい。

さらに、本発明においては、前記「実質的に金属成分を含まない」凝析剤のなかでも、半導体製造に用いられる高純度グレードの酸を用いるのが好ましい。

これにより、ポリマー中にとり込まれる金属成分量を抑えることができるという効果がえられる。

なお、生産性の点で劣るものの、含フッ素エラストマーの乳化分散液の凝析法として凍結凝析法も採用することができる。

ここで、本発明においては、含フッ素エラストマーの 乳化分散液を凝析工程に供する前に、前記乳化分散液から汚染物質を除去(汚染物質除去工程)したのちに凝析を行なうことにより含フッ素エラストマーを製造するのが好ましい。

したがって本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液から汚染物

質を除去したのちに凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法にも関する。

含フッ素エラストマーの製造においては、凝析工程を行なったのちに洗浄などにより汚染物質を除去するのは効率に劣り、実際上困難である。したがって、凝析工程の前に洗浄を行なうことにより汚染物質を除去するのが好ましい。

ここでいう汚染物質とは、金属成分だけではなく、重合開始剤、pH調整剤、原料モノマー、乳化剤などおよびこれらの残渣、原料モノマーの低分子重合体などをいう。金属成分だけではなく、前記残渣をも除去するのは、凝析工程における酸類の使用量を低減すること、および凝析したエラストマーの洗浄工程を省略するためである。酸類を含有した含水含フッ素エラストマーを粉砕するためには、金属などの粉砕力のある刃物を用いる必要があり、これにより、金属分が溶出し、混入するためである。

汚染物質を除去する方法としては、半透膜による濾過洗浄により行なうのが好ましい。具体的には、含フッ素エラストマーの乳化分散液を濾過して濃縮したのち、超純水などにより希釈し、かかる濃縮および希釈を繰り返せばよい。

濾過を行なう手段としては、特にセラミックフィルター、などの半透膜などの金属成分が溶出しにくい手段があげられる。これにより、良好な洗浄効果がえられる。

つぎに、本発明においては、含フッ素エラストマーの 乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離させる(水分分離工程)。 したがって、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤(以下、単に「非水溶性溶剤」ともいう)を添加して水分を分離させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法にも関する。

本発明においては、含水含フッ素エラストマーから水分を分離する方法としては、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加することにより行なう。さらに、この操作は繰り返して行なうことにより効果が大きくなる。

かかる非水溶性溶剤としては、たとえば、1,1-ジ クロロ-1-フルオロエタン(H C F C - 1 4 1 b)、 1,1,1,2,2-ペンタフルオロ-3,3-ジクロ ロプロパン(H C F C - 2 2 5 c a)、1,1,2,2, 3-ペンタフルオロ-1,3-ジクロロプロパン(H C F C - 2 2 5 c b)、パーフルオロヘキサン、パーフル オロ(1-クロロー4ーヒドロブタン)などがあげられ、なかでも、後の除去の容易性からHCFC-141bを用いるのが好ましい。また、この溶剤も金属成分を含まないことが重要である。これにより、水溶性物質の除去が可能となるという効果がえられる。

従来の含フッ素エラストマーの製造においては、含水 含フッ素エラストマーを乾燥させる際、通常の空気には、SiO2、金属ないのパーティクルが含まれているため、乾燥後の含フッ素エラストマーの表面に前記パーティクルが付着してままう。そこで、本発明においては、清浄ガスを用いてまり、素エラストマーを乾燥させる。また、減圧して乾燥するのが好ましい。

本発明における清浄ガスとは、 0 . 2 μ m 以上のパーティクルが 1 0 0 0 0 個以下、好ましくは 1 0 0 個以下であるガスをいう。

ここで用いることのできるガスの種類としては、特に制限はなく、たとえば、空気、チッ素、アルゴンなどの

不活性ガスなどがあげられるが、通常の空気中に含まれるTOC源やアンモニア化合物を取り除くという点から、ケミカルフィルターにて処理した空気、または窒素ガスやアルゴンガスを用いるのが好ましい。

また、清浄ガスをうる方法としては、通常用いられる PTFE製フィルターやHEPAフィルターを用いるの が一般的である。

これにより、パーティクルの削減や金属含有量の低減を図ることができるという効果がえられる。

上述のようにおいては、、本発明においては、、本発明においては、、本発明においての金属がらは、、なるされては、、で含って低減化では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、は、は、ないのでは、ないでは、ないのではないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのではないでは、ないでは、な

金属含有量が1 p p m 以下というように非常に低減化された含フッ素エラストマーを製造するためには関1に示すするで、の混入を関うしい例とは関いての混びというとは、関いての正程においてのははすってのははないに合物とし、特にポリマーと接触の多は、純水や凝析剤には高純度に精製されたものを使う。また、重合工程、凝析工程においては、乳化でカポリマーが接する部分をフッ素樹脂 P F A にておいてし、金属の混入を抑える。また、乾燥工程においてもポ

リマーが接触する部分をフッ素樹脂フィルムやフッ素樹脂製のトレイにすることで金属含有を防ぐことができる。また、乾燥には、パーティクルを含まないクリーンなエアーや不活性ガスを用いることなどがあげられる。

またこのようにして得られたクリーンな含フッ素エラストマーを非常に金属含有量の少ない充填剤を配合して得られるフッ素ゴム成形品は、成形品自体としても非常に金属含有量が低減されており、半導体シール材として従来にない非汚染性を示す。

さらに本発明は、前述のようにしてえられる含フッ素 エラストマーを含む組成物にも関する。このばあい、本 発明の方法によりえられた金属成分含有量の低減化され た含フッ素エラストマーとともに用いるほかの成分とし ては、えられる成形物の金属成分含有量、表面のパーティクル数、TOCが増加しないように、金属原子を含まないものであるのが好ましい。

ほかの成分としては、加硫剤、加硫促進剤、充填材などがあげられる。

加硫剤としては、ヨウ素または/および臭素を有する エラストマーの場合、たとえばジクミルパーオキサイド、 ベンソイルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5 - ビス (t - ブチルパーオキシ) ヘキサン、 2 , 5 - ジ メチルー2, 5-ビス(t-ブチルパーオキシ) ヘキシ ン-3、ビス(2,4-ジクロロベンゾイル)パーオキ サイド、t-ブチルクミルパーオキサイド、t-ブチル パーオキシベンゼン、1,1-ビス(t-ブチルパーオ **キシ) - 3 . 5 . 5 - トリメチルシクロヘキサン、 2 .** 5-ジメチルヘキサン-2,5-ジヒドロキシパーオキ - ジイソプロピルベンゼン、2,5-ジメチル-2,5 - ジ (ペンゾイルパーオキシ) ヘキサン、 t - ブチルパ ーオキシイソプロピルカーボネートなどの有機過酸化 物;ニトリル基を有するエラストマーの場合、たとえば、 2,2-ビス-(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス-(3,4-ジ アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、 2 , 2 - ビ ス(3-アミノ-4-メルカプトフェニル)へキサフル オロプロパンなどの2官能化合物などがあげられる。

また、加硫促進剤としては、ヨウ素または/および臭素を有するエラストマーの場合、たとえば、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート(TAIC)、

トリアリルトリメリテート、ジアリルフタレートなどの多価アリル化合物、含フッ素トリアリルイソシアヌレート、CH2=CH(CF2) nCH=CH2(n=2~6)で示されるビスオレフィンなどの含フッ素多官能オレフィンな合物などがあげられる。なかでも、加硫性、えられる加硫物の物性面という点から、トリアリルイソシアヌレート、含フッ素トリアリルイソシアヌレート、またはこれらの併用系を用いるのが好ましい。

また、充填材としては、たとえば、カーボンブラック (特に黒鉛化カーボンブラック)や酸化ケイ素、酸化チタンなどの無機フィラー、フッ素樹脂などの有機フィラーなどがあげられる。なかでも、クリーン性という点から、黒鉛化カーボンブラック、高純度合成石英シリカ、ポリテトラフルオロエチレンなどを用いるのが好ましい。

前記組成物は、各成分を常法によって混合することによりえられる。また、加硫については、常法により行な えばよい。

半導体関連製造装置などの非汚染性を強く求められる用途の場合、架橋剤などを添加せずに高エネルギー線架橋をするのが好ましい。架橋源としては、α線、β線、γ線、X線などの放射線、電子線、紫外線などが用いられる。

予備成形体に照射される高エネルギー線は、たとえば電子線の場合、照射線量は5~500kGyが好ましく、さらに好ましくは10から300kGyである。5kGyより少ないと放射線の照射による機械的強度の改善が不充分となり、500kGyより多いとポリマーの崩壊が進行し、分子間結合が一部切断されて、成形体の機械

的強度が低下する。また機械的強度の改善のためには線量率は500kGy/h以上が好ましく、さらに好ましくは1000kGy/h以上が良い。

なお、本発明でいう半導体製造装置は、特に半導体を製造するための装置に限られるものではなく、広く、液晶パネルやプラズマパネルを製造するための装置など、高度なクリーン度が要求される半導体分野において用いられる製造装置全般を含むものである。

具体的には、次のような半導体製造装置が例示される。
(1) エッチング装置

ドライエッチング 装置 プラズマエッチング 装置 反応性イオンエッチング 装置 反応性イオンビームエッチング 装置 スパッタエッチング 装置 イオンビームエッチング装置 ウェットエッチング装置 アッシング装置

(2) 洗浄装置

乾式エッチング洗浄装置 UV/O3洗浄装置 イオンピーム洗浄装置 レーザーピーム洗浄装置 プラズマ洗浄装置 ガスエッチング洗浄装置

抽出洗浄装置

ソックスレー抽出洗浄装置 高温高圧抽出洗浄装置 マイクロウェーブ抽出洗浄装置 超臨界抽出洗浄装置

(3) 露光装置

ステッパー コータ・デベロッパー

- (4) 研磨装置
 - CMP装置
- (5) 成膜装置

C V D 装置

スパッタリング装置

(6) 拡散・イオン注入装置

酸化拡散装置

イオン注入装置

以下に実施例を用いて本発明を説明するが、本発明はこれらのみに制限される物ではない。

実 施 例 1

(1) 原材料選定工程

以下に、各成分として用いたものを以下に示す。また、 これらの金属成分含有量を表1に示す。

含フッ素モノマーA:テトラフルオロエチレン(TFE) 含フッ素モノマーB:CF₃CF₂CF₂O(CF(CF₃) CF₂O)₂CF=CF₂で示されるパーフルオロアル キルビニルエーテル (PAVE)

含ヨウ素モノマー: I C H ₂ C F ₂ C F ₂ O C F = C F ₂ (I M)

ョウ素化合物:1,4-ジョードパーフルオロブタン(D I)

乳化剤: パーフルオロオクタン酸アンモニウム。 乳化剤 中の金属成分含有量は、Fe: 8 1 0 0 p p b、N a: 6 0 0 p p b、K: 2 0 0 p p b であった。

重合開始剤:過硫酸アンモニウム(APS)

p H 調整剤:炭酸アンモニウム

凝析剤: 塩酸(MERCK社製の半導体グレードHC1、Suprapur)。 HC1中の金属成分含有量は、Fe: 4ppb、Na: 4ppb、K: 1ppbであった。

非水溶性溶剤: 1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b)。 HCFC-141b中の金属成分含有量は、Fe:3ppb、Na:1ppb以下、K:2ppb以下であった。

純水:前述した方法によりえたもの。純水中の金属成分含有量は、Fe:2ppb、Na:0.7ppb、K:0.2ppb以下であった。

(2) 乳化液製造工程1(予備乳化)

純水 2 5 4 0 g、乳化剤(パーフルオロオクタン酸アンモニウム) 1 1 4 g、含フッ素モノマー(PAVE) 2 2 8 4 g、含ヨウ素モノマー(IM) 2 2 . 7 g、 PH調整剤(炭酸アンモニウム) 1 2 . 7 g、ヨウ素化合物(DI) 3 . 5 gを5 リットルのPFA製ビーカーに入れ、乳化機(ヤマト科学(株)製のULTRAーDISPERSER MODEL LKー41)を用いて、6 0 秒間混合し、体積平均粒径 2 μ mに乳化させた予備乳化液をえた。

(3) 乳化液製造工程2(強制乳化)

えられた予備乳化液を、直ちに、強制乳化機(マイクロフルーイディクス インターナショナル コーポレーション(Microfluidics International Corporation)社製のMicrofluidizer Models M-210E/H)を用い、乳化圧力1000kgf/cm²Gで乳化し、乳化液をえた。

ここで、乳化液の乳化粒径を日機装(株)製の粒度分析計UPA9340を用いて測定したところ、体積平均粒径は181nmであった。また、体積平均粒径と乳化液中に含まれるPAVEの量とから計算できる水1ml当たりの粒子数は1.55×10¹⁴個であった。乳化液のpHは8.9であった。

(4) 乳化重合工程

内容量 6 0 0 0 m 1 のステンレススチール製の耐圧反応 槽にえられた乳化液 4 3 5 0 g と亜硫酸アンモニウム (水和物) 6 . 6 g を入れ、内部空間をチッ素ガスで充

分置換したのち、撹拌下、15℃にして真空引きし、含 フッ素モノマー (TFE) のガスで4.7 k g f / c m ² G まで加圧した。 重合開始剤 (APS) の 0 . 8 8 重 量%水溶液5.4mlを圧入すると、直ちに重合反応が 始まって圧力降下が起こった。 3 . 0 k g f / c m ² G まで圧力が降下したとき、3.0kgf/cm2Gの圧 力を維持すべくTFEガスを59g追加仕込みした。追 加仕込みを終えると圧力降下が起こり、2.0kgf/ c m²Gまで圧力降下したところで2.0 k g f / c m² Gの圧力を維持すべくTFEガスを95g追加仕込みし た。この追加仕込みを終えると圧力降下が起こり、1. 0 kgf/cm²Gまで圧力降下したところで1.0 k g f / c m ² G の 圧 力 を 維 持 す べ く T F E ガ ス を さ ら に 98 g 追加仕込みした。この追加仕込みを終えた時点で 放圧し、重合を停止させた。なお、重合中には3時間ご とにAPSの0.88重量%水溶液を5.4mlずつ圧 入した。この結果として 5 0 4 9 g の水性分散液をえた。 重合時間は17時間7分であった。また、えられた水 性分散液の固形分濃度は23.2重量%で、pHは8. 3 であり、体積平均粒径は191 nm、体積平均粒径、 固形分濃度、重合終了時に残存するPAVEから計算さ れた水1ml当たりの粒子数は1.34×1014個であ った。水性分散液中の金属成分含有量を表1に示す。

(5) 汚染物質除去工程

前記(4)と同様の方法で反応スケールを約10倍とした重合でえた水性分散液20kgを140kgの水で希釈した。セラミックフィルター(U.S.FILTER社製、フィルター長さ:836mm、フィルター孔径:

200 n m 、マルチルーメン (レンコン型) 内径: 直径 4 m m × 1 2 穴、使用本数: 1 0 本)の両側に加圧可能 なタンク(容量300リットル)を2基もつ装置におい て、一方のタンク内に希釈した水性分散液を仕込んだ。 その後、希釈した水性分散液を仕込んだタンクをチッ素 ガスで 1 . 5 k g f / c m ² G に 加圧 し 、 他 方 の 空 の タ ンクを1. 3 k g f / c m 2 G に 加圧し、その差圧にて フィルター内に希釈させた水性分散液を通過させて濾過 を行なった。一方のタンク中の水性分散液がなくなった 時点で両タンクの圧力設定を逆にし、逆方向に水性分散 液を移動させた。水性分散液が特定の濃度(エラストマ 一含有量 6.0 重量%) にまで濃縮されたのちに、再度 水を140kg添加した。この工程を21時間かけて5 回繰り返した。計算された希釈倍率は612倍であった。 最終的にえられた洗浄後の水性分散液は84. 3リット ルであり、エラストマー含有量は6.0重量%であった。 また、アンモニアイオンメーターで測定したアンモニウ ムイオン濃度は77ppmであり、濾液の濃度から計算 した乳化剤に基づくアンモニウムイオン濃度は67pp m、そのほかのアンモニウムイオン濃度は10ppmで あった。

洗浄後の水性分散液中の金属成分含有量を表1に示す。 (6) 凝析工程

(5) でえられた洗浄後の水性分散液 1 9 . 3 g を水 0 . 7 g で希釈し、P F A 製ビーカーに入れた凝析剤(M E R C K 社製 S u p r a p u r : 半導体グレード H C 1 の 3 . 5 % 水溶液) 1 2 g に滴下し凝析を行なって、 含水含フッ素エラストマーをえた。

(7) 水分分離工程

(8) 乾燥工程

えられた溶剤を含むエラストマーを耐熱性HEPAフィルターを用いて庫内をクラス100の環境にしているオープン中150℃で12時間乾燥を行なった。えられたポリマーの金属成分含有量を表1に示す。

[評価]

まず、本発明において用いる金属成分含有量の分析法について説明する。

金属分を測定するには最終的には液体中で測定し、超純水、分散液などはマイクロピペットを用い、10μ1 を直接フレームレス原子吸光分光光度計(偏光ゼーマン原子吸光分光光度計 Z-8100、(株)日立製作所製)に導入し、測定する。測定の検出限界を表1に示す。

フッ素ポリマー中の金属分は、1 p p m 以上含むばあいには、測定する固体をまず白金製の蒸発皿(白金純度9 9 · 9 %)に入れ、電気炉によりポリマーを 5 0 0 ℃

にて30分間灰化した後に残存する微量金属を高純度塩酸(35%)に溶解して、フレームレス原子吸光分光光度計で吸光度を測定した。

含有金属量が1 p p m 以下の超微量のばあいには、W O 9 4 / 2 8 3 9 4 記載の測定方法を用いて測定した。 具体的には、定量すべき金属を含む所定量のサンプルを キュペット内で約1 0 0 0 ℃の灰化温度で約2 4 0 秒間 の灰化時間を含む灰化条件で灰化した後、そのままフレ ームレス原子吸光分光光度計で吸光度を測定した。

なお上記の(4)でえられた水性分散液 2 3 . 5 gを水 6 7 . 5 gで希釈し、エラストマー含有量を 6 . 0 重量%にした。この希釈水性分散液を用いること以外は上記の(6)~(8)と同様に凝析、脱水、乾燥し、エラストマーをえた。えられたエラストマーの抽出アンモニウムイオン量は 7 5 1 p p b であった。

また、凝析剤として、3.5% 試薬特級グレードHC 1水溶液12gを用いること以外は上記の(6)~(8) と同様の凝析、脱水、乾燥し、エラストマーをえた。えられたエラストマーの金属含有量は、Fe860ppb、 Na1070ppb、K150ppbであった。 実施例2(PFAライニング容器などを用いることの効果)

重合槽内部の接液部(槽内、撹拌翼、温度計さや管)に厚さ 2 0 0 μ m の P F A ライニングを施した着火源をもたない 3 リットルの反応装置の中へ水 1 . 5 リットル、パーフルオロノナン酸アンモニウム(C ₈ F ₁₇ C O O N H ₄) 1 5 g を仕込んだ。 つぎに重合槽内部から酸素を除去するため撹拌しながら T F E 加圧、排出を繰り返し

行なった。槽内を50℃に温調後、パーフルオロメチル ビニルエーテル (PMVE)、TFEを圧入し、圧力 8 kgf/cm²G、混合ガス組成比TFE/PMVE= 1 (mol%) に調整した。過硫酸アンモニウム (AP S) 30 m g を 5 m l の純水に溶解しN, で圧入し、重 合開始し、槽内圧力が7 k g f / c m 2 G になると1, 4 - ジョードパーフルオロブタンを圧入し、 T F E / P MVE=62/38 (mol%) の比率にてそれぞれの ガスを追加し、元の圧力まで昇圧した。その後、圧力が 7 k g f / c m ² G に な る 毎 に 同 様 の 昇 圧 を 繰 り 返 し た。 さらにAPSを3時間毎に10mgを5mlの純水に溶 解しN₂で圧入することを繰り返し15時間後に未反応 ガスを排出し、重合を終了した。えられた水性分散液の エラストマー含有率は27.1%、pH=2.5であっ た。えられた水性分散液中の金属含有量は、Fe:70 ppb、Na:4ppb、K:2ppb以下であった。 えられたポリマーの金属成分含有量を表1に示す。

なお、ステンレススチール製の重合槽を用いたほかは上記と同様の方法にて重合を行なった。えられた水性分散液のエラストマー含有率は26.8%で、pHは2.7であった。この水性分散液中の金属含有量は、Fe:250ppb、Na:10ppb、K:6ppbであった。

実施例3(水性分散液の洗浄方法の他の態様)

実施例 1 の (4) でえられた水性分散液 6 0 gをゲルセロファン半透膜に仕込み、純水 6 リットルにその半透膜を 2 4 時間浸したのち、新しい水に入れ替えた。この操作を 1 0 回繰り返した。アンモニアイオンメーターで

測定した水性分散液中のアンモニウムイオンは、 4 0 p p b であった。

えられた水性分散液を実施例 1 の (6) ~ (8) と同様に処理し乾燥エラストマー 1 3 g をえた。そのエラストマーのアンモニウムイオン抽出量は 8 0 p p b であった。

_	
表	

			\$	4	图	4000年	有量((pbp)				NH4+
		-		#			1	(7 77	7.2	4	(mdd)
		Fе	N a	×	Cr	Z	n C	Ca	Z Z	117	十	
	44 64 1.	2	0.7	< 0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1
	超机小	0100	008	900	1	. 1	1	1	١	_	1	1
10	乳化剤	0110	3	3								
<u> </u>	HC1 (半導体用)	4	4	-	١	i	1	1	1	1		
來		70	790	160	ı	ı	-	ı	١	1	1	,
		8	\ \ \	< 2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 5	1
	HCFC - 1410					1	1	,	,	97	۷ ک	3370
	到ル重合後の分散液 (実施例1)	120	က	2 × 2	15	∞	(2)	-	7	1.7	;	200
毗 5	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	270	14	9	18	97	120	< 1	8	70	< 5	77
 	のre & S A B M M M T E E E E E E E E E E E E E E E E	70	4	< 2	1		1	1	l	1	l	ı
臣 校	ばあいの分散液の独特の独特の	\ \ -1	\ \ 1	2 < 5	\\\\\	\ \ \ \	\ \ \	<u>^</u>	< 1	< 2	< 5	1
	JRKでいるとことには 半導体グレード HCIを用いて	440	4	< > 5	38	20	360	∞	15	20	2	1
	えたポリマー (実歴的 1)								単位	単位: ppb	1	- : 剡定せず

実施例4

(1) 乳化重合工程

内容量 6 0 0 0 m l のステンレススチール製の耐圧反 応槽にえられた超純水2リットル、乳化剤(C,F,sC OONH₄)20g、pH調節剤(炭酸アンモニウム) 1 8gを入れ、内部空間を窒素ガスで充分置換したのち、 6 0 0 r p m で撹拌下、 5 0 ℃ に昇温し、テトラフルオ ロエチレンとパーフルオロ (メチルピニルエーテル) の 混合物 (TFE/PMVE=20/80、モル比) を内 圧が12.0kgf/cm²Gまで圧入した。重合開始 剤として過硫酸アンモニウム(APS)の186mg/ ml水溶液2mlを窒素圧で圧入すると、直ちに重合反 応が始まって圧力降下が起こった。 1 1. 0 kgf/c m²Gまで圧力が降下したとき、ジョウ素化合物である I (CF₂)₄ I を 4 . 0 g 圧入し、ついでTFEを自圧に て 1 9 . 0 g 、 P M V E を 2 3 . 0 g プランジャーポン プにて圧入し、昇圧昇温を繰り返した。TFEおよびP M V E の 合 計 仕 込 量 が 4 3 0 g 、 5 1 1 g 、 5 9 6 g お よび697gに達した時点でヨウ素化合物であるICH ₂ C F ₂ C F ₂ O C F = C F ₂ を各 1 . 5 g 圧 入 し た 。 な お 、 重合中には、反応開始後、12時間毎に35mg/ml のAPS水溶液2m1を窒素ガスで圧入した。

重合反応開始から34時間後、TFEとPMVEの合計仕込み量が860gになった時点でオートクレーブを冷却し、未反応モノマーを放出して固形分濃度30.0 重量%の水性分散液を得た。

(2)凝析工程

(1) でえられた水性分散液4.0gを超純水15.

7 g で希釈し、 P F A 製ビーカーに入れた凝析剤 (M E R C K 社製 S u p r a p u r : 半導体グレード H C l の 3 . 5 % 水溶液) 1 2 g に滴下し凝析を行なって、含水含フッ素エラストマーをえた。

(3)乾燥工程

えられた溶剤を含むエラストマーを、フッ素樹脂(PFA)製フィルム上におき、耐熱性HEPAフィルターを用いて庫内をクラス100の環境にしているオーブン中150℃で12時間乾燥を行なった。えられたエラストマーのムーニー粘度(ML1+10(100℃))は61であった。 19F-NMR分析の結果、このエラストマーのモノマー単位比は、TFE/PMVE=60.3/39.7であり、ヨウ素含量は0.31重量%であった。

得られたエラストマーの金属含有量を実施例 1 と同様にして調べた結果、Fe=80ppb、Cr=10ppb、Ni=10ppb、Cu=100ppb、Na=560ppb、K=200ppb、Ca=70ppb、Mg=80ppb、Zn=40ppbおよびAl=140ppbであり、合計1290ppbであった。 実施例5

実施例4で得られたクリーン化されたフッ素系エラストマーを用い、表2に示す組成で4種類の架橋性エラストマー組成物を調製した。ここで用いる充填剤はいずれも金属含有量を低減させたものである。このエラストマー組成物を160℃10分間プレス架橋(一次架橋)し、ついで180℃4時間オーブン架橋(二次架橋)してOーリング(AS-568A-214)を作製した。

ついで、この〇ーリングに次の洗浄方法を順次施した。 (H₂SO₄/H₂O₂混合液での洗浄)

O-リング(AS-568A-214)をH2SO4/H2O2(1/1)混合液を用いて100℃にて15分間洗浄したのち、50%HF水溶液を用いて25℃にて15分間洗浄した。その後、超純水を用いて100℃にて2時間洗浄し、さらに20m1/分高純度窒素ガス気流下(容積40×40×40cm)180℃で24時間加熱して水分を除去した。この<math>O-Uングの常態(25℃)物性および圧縮永久歪みをJIS K6301にしたがって測定した。結果を表3に示す。得られた最終製品の金属含有量を調べた。結果を表3に示す。

2
表

	ĸ	.7		
		含ファ素エラン	含フッ素エラストマー組成物	
	A (透明)	B (黒系)	C (日系)	D (乳白色系)
ユ 歩びエニストラー(1)(0)	100	100	100	100
(2) (3) (4) (4) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	2.0	2.0	2.0	2.0
(1A1C(2) (8)	0.5	0.5	0.5	0.5
1 - +	i	10.0	ì	ì
(2) (2)	ı	1	10.0	ı
1 - F X (3/ (8)	1	ı	١	25.0
10 1 1 L 2 F (8)				
- 年級物件 (55 ℃)		•	7	7 7
100%引張応力 (MPa)	1.7	9.1	00	1.1
引張強さ (MPa)	10.2	22.1	20.8	0.00
毎び(%)	300	250	240	007
硬度 (ShoreA)	65	82	7.2	0,
圧縮永久歪み(%)		,	-	r.
200℃70時間	13	13	1	7

- ブチルパーオキシ) ヘキサン トーカプラック # 3885 TFE/PMVE/IM 共重合体
 トリアリルイソシアヌレート
 日本油脂株式会社製 2,5 - ジメチルー 2,5 - ジ (t - 4) 東海カーボン株式会社製黒鉛化カーボンブラック トリ) 東海カーボン株式会社製黒鉛化カーボンブラック トラ)株式会社龍森製超高純度合成石英球状シリカ
 ダイキン工業株式会社製低分子量 PTFE (3)

(4)

(5)

表 3

A 63		含有量	(ppm)	
金属	A	В	С	D
Fe	1.0	3.0	0.3	0.3
Cr	0.1	0.5	2.0	0.1
Ni	0.1	2.0	0.3	0.1
Cu	0.1	1.0	8.0	0.1
Na	0.9	2.0	2.0	1.0
K	0.2	5.0	3.0	0.9
Ca	0.4	10.0	5.0	0.2
Mg	0.2	4.0	1.0	0.2
Al	0.1	9.0	2.0	0.6

また、得られた最終製品〇一リングについて、以下に示す方法にて金属抽出量を調べた。結果を表4および表5に示す。ポリマーと充填剤ともにクリーン化されることによって、成形品自身の金属量をはじめて低減化できる。

- (1) 予め充分洗浄したPFA製容器 (フタ付き) に抽出用薬液を所定量入れる。
- (2)使用する抽出用薬液(H₂SO₄/H₂O₂(4/1) または50%HF)は、半導体用グレードを用いる。
- (3) 試料 O- リングをそれぞれの薬液中に浸漬(H_2 S O_4 / H_2 O $_2$ 混合物では 2 5 $\mathbb C$ 1 4 日間、 5 0 % H F では 2 5 $\mathbb C$ 2 4 時間)し、密封の後、所定の温度で保持する。その際試料を浸漬せず薬液のみで同様の保管をし

たものを対照とする。

(4)任意の期間保管した後、薬液中の含有金属濃度をH₂SO₄/H₂O₂についてはICP-MS(セイコー電子(株)製のSPQ9000)で、50%HFでは原子吸光測定装置((株)日立製作所製のZ-8000)で測定する。

(5)次式により〇一リングからの抽出金属を算出する。

表4はH2SO4/H2O2混合液による金属抽出量を、表5は50%HFによる金属抽出量を示す。

表 4

		抽出量	(ppb)		検出限界
金属	Α	В	С	D	(ppb)
Fe	10	20	10	10	5
Ni	40	ND	10	400	0.9
Cu	3	2	8	2	0.1
Na	1	30	10	5	0.2
К	ND	ND	ND	ND	10
Ca	ND	ND	ND	ND	5
Mg	20	4	4	4	0.1
A1	3	2	4	10	0.1

表 5

		抽出量	(ppb)		検出限界
金属	A	В	С	D	(ppb)
Fe	5.0	50.0	20.0	9.0	5
Cr	3.0	ND	3.0	2.0	2
Ni	ND	ND	ND	ND	4
Cu	ND	ND	ND	ND	0.1
Na	1.0	ND	2.0	1.0	0.5
К	ND	ND	ND	1.0	0.7
Ca	ND	7.0	20.0	.30.0	7
M g	1.0	20.0	7.0	1.0	0.2
Zn	30.0	20.0	30.0	8.0	0.6
A1	ND	ND	ND	ND	2

実施例6

(1) 乳化重合工程

着火源をもたない内容積 3 L のステンレススチール製オートクレーブに、純水 1 リットルおよび乳化 (C F 2 O C F (C F 3) C F 2 O C F (C F 3) C F 2 O C F (C F 3) C F 2 O C F (C F 3) C F 2 O C F (C F 3) C F 2 O C F (C F 3) C F 2 O C F (C F 3) C F 2 O C F

二ウムの34.3mg/mlの濃度の水溶液を10ml と過硫酸アンモニウム(APS)の135mg/mlの 濃度の水溶液10mlを順次それぞれ別々に窒素圧で圧 入して反応を開始した。

重合の進行により内圧が、7.0kgf/cm²Gまで降下した時点でCF₂=CFOCF₂CF(CF₃)OCF₂CF(CF₃)OCF₂CF(CF₃)OTュ CF₂CF (CR 3) O CF₂CF₂CN (CN VE) 3gを窒素圧にて圧入した。ついで圧力が8.0kgf/cm²Gになるように、TFEとPMVEを4.7g/5.3gの比でそれぞれ自圧にて圧入した。以後反応の進行に伴ない同様にTFE、PMVEを圧入し7~8kgf/cm²Gのあいだで、昇圧、降圧を繰り返すとともに、重合の開始から2.5時間後と5時間後に亜硫酸アンモニウムの34.3mg/mlの濃度の水溶液10mlを順次それぞれ別々に窒素圧で圧入した。

重合の開始から8時間後、TFEおよびPMVEの合計仕込み量が70gになった時点でオートクレープを冷却し、未反応モノマーを放出して固形分濃度6.1重量%の水性分散体1130gを得た。

(2)凝析工程

(1)でえられた水性分散体のうち1000gを水3 000gで希釈し、3.5重量%塩酸水溶液2400g 中に、撹拌しながらゆっくり添加した。添加後5分間撹拌した後、凝析物をろ別した。

(3) 水分分離工程

得られた含水含フッ素エラストマーをさらに1kgの HCFC-141b中にあけ、5分間撹拌し、再びろ別 した。この後このHCFC-141bによる洗浄、ろ別の操作をさらに4回繰り返した。

(4) 乾燥工程

60℃で72時間真空乾燥させ、58gのエラストマーを得た。

1°FNMR分析の結果、このエラストマーのモノマー単位組成は、TFE/PMVE/CNVE=57.3/41.5/1.2モル%であった。

このエラストマーの金属成分含有量を実施例1と同様に調べた結果、Fe=180ppb、Cr=30ppb、Ni=1100ppb、Cu=260ppb、Na=1760ppb、K=340ppb、Ca=350ppb、Mg=160ppb、Zn=240ppbおよびAl=30ppbであり、合計4450ppbであった。

産業上の利用可能性

本発明によれば、含フッ素エラストマーの金属成分含有量を内部から本質的に低減化することができ、さらに金属成分含有量が充分に低減された含フッ素エラストマーからなる成形品を提供することができる。

請求の範囲

- 1. 含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素モノマーを乳化重合させる際に金属化合物を配合しない含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 2. 金属化合物を用いない含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いるガス状のモノマーを除く原材料のうち少なくとも 1つの原材料を、実質的に金属成分を含まない原材料 とする含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 3. 含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が重合媒体用の水である請求の範囲第2項に記載の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 4. 含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が凝析用の凝析剤である請求の範囲第2項に記載の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 5. 含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が凝析してえられる含水含フッ素エラストマーから水分を分離する際に添加する該含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤である請求の範囲第2項に記載の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 6. 含フッ素エラストマーの製造において、乳化液を弱アルカリ性に保持して含フッ素エラストマーの乳化重合を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 7. 含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を濾過して汚染物質を除去し

たのちに凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。

- 8. 含フッ素エラストマーの製造において、金属元素を含まない酸を用いて含フッ素エラストマーの乳化分散液の凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 9. 含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 10. 含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの製造において、含含水含フッストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水合フッ素エラストマー、または該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離してえられるエラストマー凝析物を、清浄なガスを用いて乾燥させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 11. 含フッ素エラストマーの製造において、エラストマー凝析物と接触する部分がフッ素樹脂製フィルムまたはポリエチレン製フィルムをラミネートした容器、フッ素樹脂製容器およびポリエチレン樹脂製容器を用いる請求の範囲第10項記載の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 12. 請求の範囲第1項~第11項に記載の方法のうち少なくとも2つの方法からなる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 13. 金属化合物を用いない含フッ素エラストマーの製造

において、含フッ素モノマーの重合、凝析およる含化性に用いるすべての原材料に実質的に金属成分を経析ない、乳化を関いて、乳化がフットでを関いて、乳化や関されてが多数にはポリストを用いる装置を用い、かって、治を用いて、治を用いて、治を用いて、治を用いて、治の金属を有量低減化方法。

- 14. 金属含有量が50ppm以下の含フッ素エラストマー。
- 15. 金属含有量が 1 0 p p m 以下の含フッ素エラストマー。
- 16. 請求の範囲第1項~第13項のいずれかに記載の方法の1つまたは2つ以上を組合せてえられる金属含有量が50ppm以下の含フッ素エラストマー。
- 17. 請求の範囲第1項~第13項のいずれかに記載の方法の1つまたは2つ以上を組合せてえられる金属含有量が10ppm以下の含フッ素エラストマー。
- 18. テトラフルオロエチレン $40 \sim 90$ モル%、式(1): CF₂ = CF OR₄

(式中、R、は炭素数 1~5のパーフルオロアルキル基、または炭素数 3~12でかつ酸素原子を1~3個含むパーフルオロアルキル(ポリ)エーテル基)で表されるパーフルオロビニルエーテル10~60モル%、および硬化部位を与える単量体0~5モル%からなる請求の範囲第14項に記載の含フッ素エラストマー。

19. ビニリデンフルオライド 3 0 ~ 9 0 モル % 、 ヘキサ フルオロプロピレン 1 5 ~ 4 0 モル % およびテトラフ ルオロエチレン 0 ~ 3 0 モル%からなる請求の範囲第 1 4 項に記載の含フッ素エラストマー。

20. ビニリデンフルオライド $10 \sim 90$ モル%、式(1): CF,=CF-OR,

(式中、R、は炭素数 1 ~ 5 のパーフルオロアルキル基、または炭素数 3 ~ 1 2 でかつ酸素原子を 1 ~ 3 個含むパーフルオロアルキル (ポリ) エーテル基) で表されるパーフルオロビニルエーテル 1 0 ~ 4 0 モル % およびテトラフルオロエチレン 0 ~ 8 0 モル % からなる請求の範囲第 1 4 項に記載の含フッ素エラストマー。

21. エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントと非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントを有する含フッ素多元セグメント化ポリマーであって、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが、テトラフルオロエチレン40~90モル%、式(1):

 $CF_{\circ} = CF - OR_{\circ}$

(式中、R、は炭素数 1 ~ 5 のパーフルオロアルキル基、または炭素数 3 ~ 1 2 でかつ酸素原子を 1 ~ 3 個含むパーフルオロアルキル(ポリ)エーテル基)で表されるパーフルオロビニルエーテル 1 0 ~ 6 0 モル%、および硬化部位を与える単量体 0 ~ 5 モル% からなり、非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが、テトラフルオロエチレン 8 5 ~ 1 0 0 モル%、式(2):

 $C F_{2} = C F - R_{f}^{1}$

(式中、R₁¹はCF₃またはOR₁²(R₁²は炭素数1~5のパーフルオロアルキル基))0~15モル%からなる請求の範囲第14項に記載の含フッ素エラストマ

WO 99/50319 PCT/JP9

51

- 22. 末端および/または側鎖にヨウ素および/または臭素を有するポリマー鎖を含む請求の範囲第18項~第21項のいずれかに記載の含フッ素エラストマー。
- 23. ニトリル基を含む請求の範囲第18項~第21項の いずれかに記載の含フッ素エラストマー。
- 24. 請求の範囲第14項~第23項のいずれかに記載の 含フッ素エラストマーを含む組成物。
- 25. 請求の範囲第24項に記載の組成物からなる成形品。
- 26. 金属含有量が50ppm以下である請求の範囲第25項に記載の成形品。
- 27. 金属含有量が 1 0 p p m 以下である請求の範囲第 2 5 項に記載の成形品。
- 28. 半導体製造装置用シール材である請求の範囲第25 項~第27項のいずれかに記載の成形品。
- 29. 請求の範囲第25項~第28項のいずれかに記載の 成形品が組み込まれた半導体製造装置。
- 30. 含フッ素ポリマーの製造において、重合用原材料および生成物と接触する部分がフッ素樹脂またはポリエチレン樹脂でライニングされた装置を用いる含フッ素ポリマーの金属含有量低減化方法。
- 31. フッ素樹脂でライニングされた装置が、重合槽およびそれに付属する撹拌翼、邪魔板などの重合装置、凝析装置、洗浄装置、乾燥装置、およびこれらの配管類である請求の範囲第30項に記載の含フッ素ポリマーの金属含有量低減化方法。
- 32. フッ素 樹脂 がテトラフルオロエチレン/パーフルオロ (アルキルビニルエーテル) 共重合体である請求の範囲第30項に記載の含フッ素ポリマーの金属含有量

低減化方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/01517

	FIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 CO8F14/18, C08F2/00, C08F6	5/00			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
B. FIELDS	S SEARCHED				
Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 C08F14/18, C08F2/00, C08F6	5/00			
Jitsu Kokai	ion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1926–1999 i Jitsuyo Shinan Koho 1971–1999	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	0 1994–1999		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	ne of data base and, where practicable, se	arch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.		
X Y	JP, 9-500163, A (E.I. Du Pon 7 January, 1997 (07. 01. 97) Claims; page 5, line 6 to page lines 13 to 24 & WO, 9502634, Al & EP, 708	, e 6, line 22 ; page 10,	14-20, 22-29 1-13, 21, 30-32		
X Y	WO, 97/08239, A1 (Morisei Kako Co., Ltd.), 6 March, 1997 (06. 03. 97), Claims 14-18, 20, 24-29 1-13, 19, 21-23, 30-32				
X Y	JP, 9-183812, A (Dyneon GmbH 15 July, 1997 (15. 07. 97), Claims; page 2, right column page 3, left column, line 30 line 6; page 3, right column, column, line 12 & EP, 780403, A2 & US, 586	n, lines 22 to 28; to right column, line 43 to page 4, left	1-2, 14-18, 24-27 3-13, 19-23,		
× Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docum conside "E" earlier "L" docum cited to special "O" docum means "P" docum the pri	* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance to decument but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is at a considered to involve an inventive step when the document is a considered to involve an inventive step when the document is a considered to involve an inventive step when the document is a considered to involve an inventive step when the document is a considered to involve an inv				
	June, 1999 (22. 06. 99) mailing address of the ISA/	Authorized officer	-		
	anese Patent Office				
Facsimile N	No.	Telephone No.			

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP, 51-31789, A (Dynamit Nobel AG.), 18 March, 1976 (18. 03. 76), Claims; page 1, lower right column, lines 12 to 19 & US, 3997705, A	1-2, 4, 8 3, 5-7, 9-32
X Y	JP, 62-285906, A (Daikin Industries,Ltd.), 11 December, 1987 (11. 12. 87), Claims (Family: none)	1, 5, 9 2-4, 6-8, 10-32
X Y	JP, 55-29519, A (Asahi Glass Co., Ltd.), 1 March, 1980 (01. 03. 80), Claims; page 4, lower left column, line 10 to page 5, upper left column, line 16 (Family: none)	1, 6 2-5, 7-32
X Y	JP, 7-179508, A (Ausimont S.p.A.), 18 July, 1995 (18. 07. 95), Claims & EP, 648787, A1 & US, 5608020, A	1, 6 2-5, 7-32
X Y	JP, 1-197510, A (Dainippon Ink & Chemicals, Inc.), 9 August, 1989 (09. 08. 89), Claims; page 2, upper left column, line 9 to upper right column, line 17 (Family: none)	1 2-32
Y	JP, 37-12536, B1 (Imperial Chemical Industries PLC.), 31 August, 1962 (31. 08. 62), Claims	7
Y	JP, 59-59764, A (Daikin Industries,Ltd.), 5 April, 1984 (05. 04. 84), Claims; page 2, upper right column, line 12 to lower left column, line 20 (Family: none)	21
Y	JP, 60-240713, A (E.I. Du Pont de Nemours & Co.), 29 November, 1985 (29. 11. 85), Claims; page 3, upper right column, lines 2 to 11; page 5, upper right column, line 16 to lower right column, line 10 & CA, 1248292, A	1-32
	$^{\diamond}$	

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl°	C08F14/18, C08F2	2/00, C08F6/00		
B. 調査を行った分	野			
調査を行った最小限資	料(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	C08F14/18, C08F2	2/00, C08F6/00		
最小限資料以外の資料	で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実用新賀				
日本国公開実月日本国登録実月	用新案公報 1971-1999年 用新案公報 1994-1999年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)				
C. 関連すると認め 引用文献の	られる文献			
	用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X Y 7. 頁64	9-500163, A (イー・アンド・カンパニー) 1月、1997 (07.01.5 万目-第6頁22行目, 第105 634, A1&EP, 7087	97),特許請求の範囲,第5 頁13-24行目&WO.95	14-20, 22-29 1-13, 21, 30- 32	
X 6.	97/08239, A1(株式 3月. 1997(06. 03.) 情求の範囲	式会社森清化工) 9 7),	14-18, 20, 24- 29 1-13, 19, 21- 23, 30-32	
X C欄の続きにも文	献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であってて出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了した日	22.06.99	国際調査報告の発送日 06.07	.99	
郵便番号	びあて先 (ISA/JP) 100-8915 区質が関三丁目4番3号	. 特許庁審査官(権限のある職員) 原 賢一 印 一 電話番号 03-3581-1101	•	

国際調査報告

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP, 9-183812, A (デユネオン・グゼルシヤフト・ミト・ベシユレンクテル・ハフツング) 15. 7月. 1997 (15. 07. 97), 特許請求の範囲, 第2頁右欄22-28行目, 第3頁左欄30行目 -右欄6行目, 第3頁右欄43行目-第4頁左欄12行目&EP, 780403, A2&US, 5861464, A	1-2, 14-18, 24 -27 3-13, 19-23, 28-32
· X ·	JP, 51-31789, A(デイナミート・ノーベル・アクチエンゲゼルシヤフト) 18. 3月. 1976(18. 03. 76), 特許請求の範囲, 第1頁右下欄12-19行目&US, 39977 05, A	1-2, 4, 8 3, 5-7, 9-32
X	JP, 62-285906, A (ダイキン工業株式会社) 11. 12月. 1987 (11. 12. 87), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1, 5, 9 2-4, 6-8, 10- 32
X	JP, 55-29519, A(旭硝子株式会社) 1.3月.1980(01.03.80), 特許請求の範囲,第4頁左下欄10行目-第5頁左上欄16行目 (ファミリーなし)	1, 6 2-5, 7-32
X Y	JP, 7-179508, A (オーシモント エス. ピー. エー.) 18. 7月. 1995 (18. 07. 95), 特許請求の範囲&EP, 648787, A1&US, 560802 0, A	1, 6 2-5, 7-32
X	JP, 1-197510, A (大日本インキ化学工業株式会社) 9.8月.1989 (09.08.89), 特許請求の範囲,第2頁左上欄9行目-右上欄17行目 (ファミリーなし)	1 2-32
Y	JP, 37-12536, B1 (イムペリアル. ケミカル. インダストリイス. リミテツド) 31. 8月. 1962 (31. 08. 62), 特許請求の範囲	7
Y	JP, 59-59764, A (ダイキン工業株式会社) 5.4月.1984 (05.04.84), 特許請求の範囲,第2頁右上欄12行目-左下欄20行目 (ファミリーなし)	21
Y	JP, 60-240713, A (イー・アイ・デユポン・デ・ニモアス・アンド・カンパニー) 29. 11月. 1985 (29. 11. 85), 特許請求の範囲, 第3頁右上欄2-11行目, 第5頁右上欄16行目-右下欄10行目&CA, 1248292, A	1-32